„KÏ0 ¹ ó Ö2010 H3 Ü30 ¹

"#z ,+ $ IGBT ¹8N G ÄEîE› /¥L6 ,+ $ { •A’AuP`A•
ä Ñ Y1 Ô 5 ` HEîE› v { •A’AuP`A•,X IGBT ¹8N4“

+ Ñ/¥ :L6 ,+ $-è0J Ä ¹ ß1T/Ä “ /¥L6 ,+ $ ” ÅA’Au-è ¥,X4±4ì Ù { U J '1u Ä“Insulated Gate Bipolar Transistor È1T/Ä IGBT” Å2Ï ë { • b ¹ ! ü "#z ,+ $ ÝL$ @ Ì Ä ¹ ß1T/Ä“ "#z ,+ $ ” Å,X ¹8N G Ä Þ# (ä s È ØNM – D E’ A’Au?U" È Û «- "#z ,+ $ ¹ Ý Z Ñ Y1 Ô 5 ` HEîE› v { •A’AuP`A•,X IGBT ¹8N4“ È •!7 š Û Ü 0 ¹ E¯ Ô!9 | | Ñ {7¾ IGBT { •,X û MG£*ó {E¯/ß È ¹ # } |E¯ r)„ Ñ Y IGBT { î ê,X,Â Û Ä

E- õ# (ä s,X { •G›*ü Planar NPT < Ê4§ X È?˜ 15-43A /1200V ÄE- þ { • M6 å Š*ü+ < h*üNZ ³ È,Â !!7+ Ñ Y:+ á,X Š+ Õ î v A©*üA˜ Ä

"#z ,+ $ ÝL$ @ ÌKS ó ¹ 9 ¤ õ { :-è Ü 0,X õ ã È â Ñ Y:+ á/¥-èL6 ž û : ü „ _+ o+ $ < Ê •M6,X T Ü 0+ 9 Æ Ä ü!8 IGBT NM,Â Ü 0 ! È • Ò6(Ü+ $/¥ T û :+ AË J ä s9‹ k Z Ñ Š „ _+ o+ $NM,Â,X Õ Ä ü IGBT NM,Â k L !‰ û ä p Ê È • Ú4»4Á ¥ ù Ø7¾,X ì “ ÈE¯ Ô!9 ü Ù À IGBT 1 •M6,X8V 6ÑL!5ëNZ ³) Ô š Û,X Ü 0 Ä

B Ñ Y Õ,X Ö A× ¹ XC m È 2009 H Ñ IGBT ,X Ö ?˜ õE’ 38.2 “ Ž!å Õ ÈNX ó2010 H Ñ IGBT Ö ?˜ õ 41.4 “ Ž!å Õ ÈEW 2009 H äKS 8.4% Ä 2011 H â 2012 H Ú ÿE’ 45.3 â 50.6 “ Ž!å Õ È rKS)[Ú ÿ 9.4% â 11.7% Ä È Ý Ð ' XNX# IGBT ü 2010 H ü Ñ,X äKS ÚE’ 25% ¹ Þ ÄM6 Í û,X Ö LÔ" È Ñ,Â !E¬"u Ý Ô 5 ` H,X IGBT *ó {4“ Ã ¹ ¤ o4œ0Ã v S *ü È ´!8 ™NO qC*E¯ · Ä

IGBT + U _ J '1u Ä1T/Ä “BJT” Å `4±4ì Ù _ h J '1u Ä1T/Ä “MOSFET” Å ,Ì4§ Ü,X+ _PE | ã s)[Ð ' < Ê Ä ¶ Ý s)[MOSFET Eg 9L kP¬ È { s)[ã È ç bPE | È { 1T) Ã Ô GNe)[P¬,X ì&• È œ Ý U J '1u,X ÐEî+ _ " ÈEî Õ+ # û È 35ë ã,X :+ ì&• Ä ü ¤ õ8V6Ñ £ f Ã ".‡4£#",X Ê · È K Û8V6Ñ)[P¬ È “ b?˜ õ ê*ó { ÈEW ç r)„8V6Ñ N ; ê1 ì&•,X IGBT Æ ä s)[Ð ' Ö ¥),X # T ÄIGBT ?U*ü ü Š+ { • Ã ¹ î { Ã5%4°Eî Ã'; â Ã#\C + $ Ã Au1k ž"QE:+ $1 È5à N6Ñ+ 5% ÃP¬EóJ•CÃ Ã „6Ñ$d"QE: IGBT ÔEs Z È t S "¯,X h*ü Ö Ä

■ G b "#z ,+ $

"#z ,+ $ ž JL 2 @ Ì ÑNZ ,X õ ³ Ð ' @ Ì È J î u Ù À Ô ã J Ú ·
¹ ÃLš ä+ CÃA’Au ÃLš ä+ CÃ Õ>™# A© ` Ú0Ÿ < Ê ¯ û Ð ' î u S + Ä "#z ,+
$ Om$ S Þ Ö @ Ì Ä 0597.HK Å È2008 H z9ù îNq 31.18 “$ Õ È Ñ Y !
h û Ð ' Eô Ô Ä

■ G b /¥L6 ,+ $

/¥L6 ,+ $ Ô çK¼ ¢ _ ,+ $NZ ³-è0J â Ô ¥,X Ñ0Ÿ-è0J X È ü î þ •
å Ø b Ñ YNZ ! È ª k Z .),X ä p È Ñ ,+ $ T ` { î ¥) 0 Î ZG¡
?UBõ) ÄA¹ ü VDMOS ÃIGBT 1 s)[< ÊNZ ³,X-è Ý ` î H,X T /Ã3 ` Î
. È,Â !!77È o bM6 å N6Ñ+ 5% `+ |"QE:P¬0Ã h*üNZ ³,X IGBT 2Ï ë { • Ô ¥ Ä

„KÏ6(2Ï Ž Ö

"#z ,+ $ ÝL$ @ Ì /ß)
+ A± Ö (+86-510) 8180 5021
Ö (+86) 1381203 1495
ô,ó Ö (+86-510) 8580 4647
+ $F,1… Ö chengj@crmh.com.cn